

**Dk 3.1 Df 0.0012
@14GHz**

**Tg (DMA)
220°C**

**T288 (銅付)
>120分**

用途 ネットワーク/ワイヤレス通信

ルータ、スイッチ、光伝送装置、サーバ、AIサーバ、
基地局、半導体試験装置、プローブカードなど

MEGTRON8

Laminate

R-5795(U)* R-5795(N)**

Prepreg

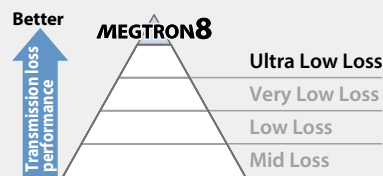
R-5690(U)* R-5690(N)**

*Ultra-low Df glass cloth type

**Low Dk glass cloth type

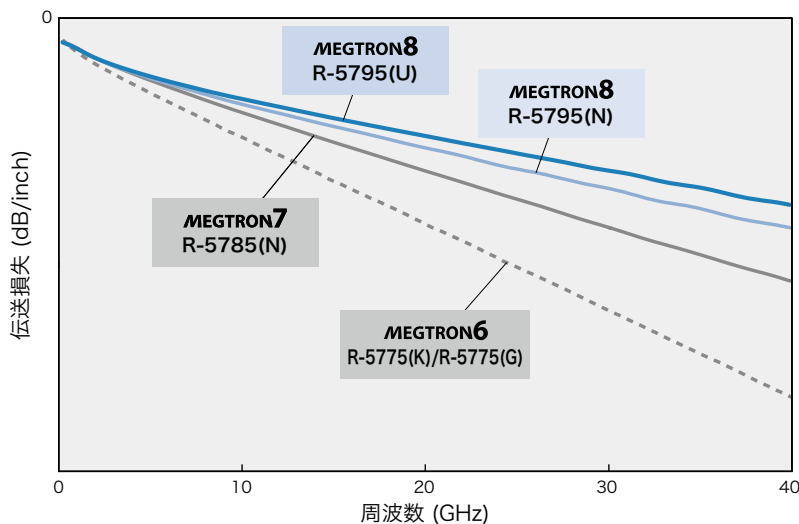
超低伝送損失・高耐熱多層基板材料

次世代高速通信技術800GbE対応。
MEGTRON8 R-5795(U)と
MEGTRON7 R-5785(N)比較で伝送損失
を約30%改善(28GHz時)し、高速通
信ネットワーク機器の性能向上に貢献。



伝送損失比較

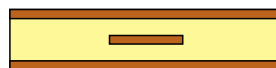
MEGTRON7 R-5785(N)と比較し、伝送損失を約30%改善(**)



(**) 28GHz時の伝送損失改善効果

$$\frac{\Delta \text{伝送損失の差(MEGTRON7 - MEGTRON8)}}{\text{伝送損失(MEGTRON7)}} \times 100 \approx 30\%$$

評価サンプル (断面図)



PCB構成	3層PCB ストリップライン
銅箔厚み	18 μm(内層)
コア材	0.13mm
プリプレグ	0.15mm
特性インピーダンス	50Ω
内層表面処理	表面処理なし
測定方法	2ポート Sパラメータ
測定周波数	0.2 - 40GHz
校正方法	マルチラインTRL法

上記データは当社測定値であり、保証値ではありません。

一般特性

項目	試験方法	条件	単位	MEGTRON8 R-5795(U)	MEGTRON8 R-5795(N)	MEGTRON7 R-5785(N)	
				Ultra-low Df glass cloth	Low Dk glass cloth	Low Dk glass cloth	
ガラス転移温度(Tg)	DMA	A	°C	220	220	200	
熱膨張係数 (厚さ方向)	α1	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	50	45	
					α2	270	320
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	>120	>120	>120	
比誘電率(Dk)	14GHz	平衡型円板共振器法	C-24/23/50	-	3.1	3.2	
誘電正接(Df)					0.0012	0.0016	0.0021
銅箔引き剥がし強さ	1oz(35 μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.7 [H-VLP3]	0.7 [H-VLP3]	0.8 [H-VLP]

試験片の厚さは0.75mmです。
試験片の構成は #1078 x 10plyです。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。